(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-149571

(43)公開日 平成10年(1998)6月2日

(51) Int.Cl.6

識別記号

FΙ

G 1 1 B 7/135 7/20

G11B 7/135 7/20

Z

審査請求 有 請求項の数26 OL (全 23 頁)

(21)出願番号

特願平8-309647

(22)出願日

平成8年(1996)11月20日

(71)出願人 000001889

三洋電機株式会社

大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号

(72)発明者 梶山 清治

大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三

洋電機株式会社内

(72)発明者 加納 康行

大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三

洋電機株式会社内

(72)発明者 山田 真人

大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三

洋電機株式会社内

(74)代理人 弁理士 安富 耕二 (外1名)

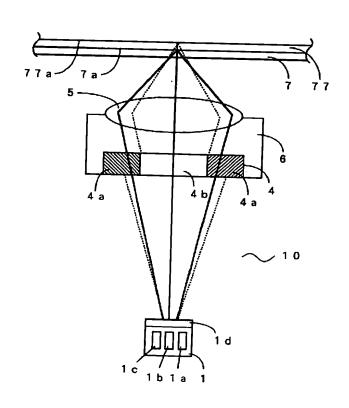
最終頁に続く

(54)【発明の名称】 光ピックアップ装置

(57)【要約】

【課題】 波長635nmのレーザビームを用いて薄型の光ディスクであるDVDと標準厚で追記型の光ディスクであるCD-Rとの互換再生をすることができない。

【解決手段】 記録または/および再生が行われるべき 光ディスクに対向して設けられた対物レンズと、記録ま たは/および再生が行われるべき光ディスクの透明基板 の厚さに応じて対物レンズの開口数を変更する開口数変 更手段と、第1の波長を持つ第1のレーザ光と、第1の 波長と異なる第2の波長を持つ第2のレーザ光とを選択 的に生成し、その生成された第1のレーザ光を第1の方 向に回折させ、第2のレーザ光を第1の方向と異なる第 2の方向に回折させ、その回折させたレーザ光を対物レ ンズに導き、第1のレーザ光、および第2のレーザ光の 光ディスクの信号記録面からの反射光を検出する光学手 段とから光ピックアップを構成する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 第1の厚さの透明基板を有する第1の光ディスク、および前記第1の厚さと異なる第2の厚さの透明基板を有する第2の光ディスクの記録または/および再生を行う光ピックアップ装置であって、

1

前記記録または/および再生が行われるべき光ディスク に対向して設けられた対物レンズと、

前記記録または/および再生が行われるべき光ディスク の透明基板の厚さに応じて前記対物レンズの開口数を変 更する開口数変更手段と、

第1の波長を持つ第1のレーザ光と、前記第1の波長と 異なる第2の波長を持つ第2のレーザ光とを選択的に生成し、その生成された前記第1のレーザ光を第1の方向 に回折させ、前記第2のレーザ光を前記第1の方向と異なる第2の方向に回折させ、該回折させたレーザ光を前 記対物レンズに導き、前記第1のレーザ光、および前記 第2のレーザ光の前記光ディスクの信号記録面からの反射光を検出する光学手段とを含む光ピックアップ装置。

【請求項2】 第1の厚さの透明基板を有する第1の光 ディスク、および前記第1の厚さと異なる第2の厚さの 20 透明基板を有する第2の光ディスクの記録または/およ び再生を行う光ピックアップ装置であって、

前記記録または/および再生が行われるべき光ディスク に対向して設けられた対物レンズと、

前記記録または/および再生が行われるべき光ディスク の透明基板の厚さに応じて前記対物レンズの開口数を変 更する開口数変更手段と、

第1の波長を持つ第1のレーザ光と、前記第1の波長と 異なる第2の波長を持つ第2のレーザ光とを選択的に生 成し、

前記第1のレーザ光、および前記第2のレーザ光の前記 光ディスクの信号記録面からの反射光を検出する光学手 段と、

前記光学手段からの前記第1のレーザ光を第1の方向に回折させ、前記第2のレーザ光を前記第1の方向と異なる第2の方向に回折させ、その回折させたレーザ光を前記対物レンズに導くとともに、

前記第1のレーザ光、および前記第2のレーザ光の前記 光ディスクの信号記録面からの反射光を前記光学手段に 導くホログラムとを含む光ピックアップ装置。

【請求項3】 第1の厚さの透明基板を有する第1の光ディスク、および前記第1の厚さと異なる第2の厚さの透明基板を有する第2の光ディスクの記録または/および再生を行う光ピックアップ装置であって、

前記記録または/および再生が行われるべき光ディスク に対向して設けられた対物レンズと、

前記記録または/および再生が行われるべき光ディスク の透明基板の厚さに応じて前記対物レンズの開口数を変 更する開口数変更手段と、

第1の波長を持つ第1のレーザ光と、前記第1の波長と 50

異なる第2の波長を持つ第2のレーザ光とを選択的に生成し、その生成された前記第1のレーザ光を第1の方向に回折させ、前記第2のレーザ光を前記第1の方向と異なる第2の方向に回折させるとともに、

前記第1のレーザ光、および前記第2のレーザ光の前記 光ディスクの信号記録面からの反射光を検出する光学手 段と、

前記光学手段からの第1のレーザ光、および前記第2の レーザ光を受け、その受けたレーザ光を前記対物レンズ 10 に導くコリメータレンズとを含む光ピックアップ装置。

【請求項4】 第1の厚さの透明基板を有する第1の光ディスク、および前記第1の厚さと異なる第2の厚さの透明基板を有する第2の光ディスクの記録または/および再生を行う光ピックアップ装置であって、

前記記録または/および再生が行われるべき光ディスク に対向して設けられた対物レンズと、

前記記録または/および再生が行われるべき光ディスク の透明基板の厚さに応じて前記対物レンズの開口数を変 更する開口数変更手段と、

第1の波長を持つ第1のレーザ光と、前記第1の波長と 異なる第2の波長を持つ第2のレーザ光とを選択的に生成し、

前記第1のレーザ光、および前記第2のレーザ光の前記 光ディスクの信号記録面からの反射光を検出する光学手 段と、

前記レーザ光生成手段から前記第1のレーザ光、および 前記第2のレーザ光を受け、その受けた光を前記対物レ ンズに導くコリメータレンズと、

前記コリメータレンズの直前または直後に設けられ、前 30 記第1のレーザ光を第1の方向に回折させ、前記第2の レーザ光を前記第1の方向と異なる第2の方向に回折さ せるとともに、

前記第1のレーザ光、および前記第2のレーザ光の前記 光ディスクの信号記録面からの反射光を前記光学手段に 導くホログラムとを含む光ピックアップ装置。

【請求項5】 請求項4において、

前記ホログラムは、前記コリメータレンズと一体的に設けられている光ピックアップ装置。

【請求項6】 請求項1または3において、

40 前記光学手段は、

前記第1のレーザ光を生成する第1の半導体レーザと、 前記第2のレーザ光を生成する第2の半導体レーザと、 前記第1のレーザ光、および前記第2のレーザ光の前記 光ディスクの信号記録面からの反射光を検出する光検出 手段と、

前記第1の半導体レーザにより生成された前記第1のレーザ光を第1の方向に回折させ、前記第2の半導体レーザにより生成された前記第2のレーザ光を前記第1の方向と異なる第2の方向に回折させるとともに、

) 前記第1のレーザ光、および前記第2のレーザ光の前記

光ディスクの信号記録面からの反射光を前記光検出手段 に導くホログラムとを含む光ピックアップ装置。

【請求項7】 請求項2または4または5において、 前記光学手段は、

前記第1のレーザ光を生成する第1の半導体レーザと、 前記第2のレーザ光を生成する第2の半導体レーザと、 前記第1のレーザ光、および前記第2のレーザ光の前記 光ディスクの信号記録面からの反射光を検出する光検出 手段とを含む光ピックアップ装置。

【請求項8】 請求項6または7において、

前記第1の半導体レーザと前記第2の半導体レーザは、 前記第1のレーザ光、および前記第2のレーザ光の前記 信号記録面からの反射光が前記光検出手段の同じ位置で 検出されるように配置されている光ピックアップ装置。

【請求項9】 請求項8において、 前記第2の半導体レーザは、前記第1の半導体レーザに 対して前記光ディスクの外径方向に配置されている光ピ

ックアップ装置。

【請求項10】 請求項8において、

前記第1の半導体レーザと前記第2の半導体レーザと は、前記光ディスクの円周方向に配置されている光ピッ クアップ装置。

【請求項11】 請求項8から10において、

前記第1の半導体レーザと前記第2の半導体レーザとの距離を Z_0 、前記第1の半導体レーザと前記光検出手段との距離を Z_1 、前記第2の半導体レーザと前記光検出手段との距離を Z_1 、前記第1の半導体レーザと前記ホログラムとの距離をL、前記ホログラムのピッチをD、前記第1のレーザ光の波長をD、前記第D0レーザ光の波長をD0、前記第D0 とした場合に、

 $Z_1 = L \lambda_1 / (p^2 - \lambda_1^2)^{1/2}, Z_1 = L \lambda_2 / (p^2 - \lambda_1^2)$

 $Z_0 = Z_1 - Z_1$ なる関係を有する光ピックアップ装置。

【請求項12】 請求項11において、

前記第1のレーザ光の波長 \(\righta\) は、620~660 nm の範囲であり、

前記第2のレーザ光の波長λ,は、760~800nm の範囲である光ピックアップ装置。

【請求項13】 請求項11において、

前記第1のレーザ光の波長λ,は、350~550 nm の範囲であり、

前記第2のレーザ光の波長 λ ,は、620~660nm の範囲である光ピックアップ装置。

【請求項14】 請求項11において、

前記第1のレーザ光の波長λ,は、350~550nm の範囲であり、

前記第2のレーザ光の波長入,は、760~800nm の範囲である光ピックアップ装置。

【請求項15】 請求項12において、

前記第1の半導体レーザと前記第2の半導体レーザとの 50 ップ装置。

距離 2。は、 $0.1 \sim 0.5$ mmの範囲である光ピックアップ装置。

【請求項16】 請求項12において、

前記第1の半導体レーザと前記第2の半導体レーザとの距離2。は、 $0.1\sim0.5$ mmの範囲であり、

前記第1の半導体レーザと前記光検出手段との距離2には、 $0.50\sim2.2$ mmの範囲である光ピックアップ装置。

【請求項17】 請求項12において、

10 前記第1の半導体レーザと前記第2の半導体レーザとの 距離 Z。は、0.1~0.5 mmの範囲であり、

前記第1の半導体レーザと前記光検出手段との距離Z、は、 $0.50\sim2.2$ mmの範囲であり、

前記ホログラムのピッチpは、 $1.5 \sim 3.5 \mu$ mの範囲であり、

前記第1の半導体レーザと前記ホログラムとの距離しは 3~25mmの範囲である光ピックアップ装置。

【請求項18】 請求項15から17において、

前記第1の光ディスクの厚さは、0.55~0.65mm 20 の範囲であり、

前記第2の光ディスクの厚さは、 $1.1 \sim 1.3 \, \text{mm}$ の範囲である光ピックアップ装置。

【請求項19】 請求項13において、

前記第1の半導体レーザと前記第2の半導体レーザとの 距離 Z_0 は、 $0.1 \sim 0.5 mm$ の範囲である光ピックアップ装置。

【請求項20】 請求項13において、

前記第1の半導体レーザと前記第2の半導体レーザとの距離2。は、 $0.1 \sim 0.5$ mmの範囲であり、

30 前記第1の半導体レーザと前記光検出手段との距離 Z₁ は、0.3~1.5 mmの範囲である光ピックアップ装

【請求項21】 請求項13において、

前記第1の半導体レーザと前記第2の半導体レーザとの距離Z。は、 $0.1 \sim 0.5$ mmの範囲であり、

前記第1の半導体レーザと前記光検出手段との距離 Z_1 は、 $0.3 \sim 1.5$ mmの範囲であり、

前記ホログラムのピッチ p は、 $3 \sim 12 \mu$ m の範囲であり、

40 前記第1の半導体レーザと前記ホログラムとの距離しは 3~15mmの範囲である光ピックアップ装置。

【請求項22】 請求項19から21において、

前記第1の光ディスクの厚さは、0.25~0.35mm の範囲であり、

前記第2の光ディスクの厚さは、 $0.55\sim0.65$ mm の範囲である光ピックアップ装置。

【請求項23】 請求項14において、

前記第1の半導体レーザと前記第2の半導体レーザとの距離Z。は、 $0.1\sim0.5$ mmの範囲である光ピックアップ装置。

1

5

【請求項24】 請求項14において、 前記第1の半導体レーザと前記第2の半導体レーザとの 距離2。は、0.1~0.5 mmの範囲であり、

前記第1の半導体レーザと前記光検出手段との距離 Z_1 は、 $0.2 \sim 1.0 \, \text{mm}$ の範囲である光ピックアップ装置。

【請求項25】 請求項14において、

前記第1の半導体レーザと前記第2の半導体レーザとの距離2。は、 $0.1 \sim 0.5$ mmの範囲であり、

前記第1の半導体レーザと前記光検出手段との距離 Z_1 は、 $0.2 \sim 1.0 \text{ mm}$ の範囲であり、

前記ホログラムのピッチ p は、 $5\sim12~\mu$ mの範囲であり、

前記第1の半導体レーザと前記ホログラムとの距離しは 2~15mmの範囲である光ピックアップ装置。

【請求項26】 請求項23から25において、

前記第1の光ディスクの厚さは、 $0.25\sim0.35$ mmの範囲であり、

前記第2の光ディスクの厚さは、 $1.1 \sim 1.3 \, \text{mm}$ の範囲である光ピックアップ装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、基板厚、記録密度 の異なる複数種類の光ディスクの再生装置に関する。

[0002]

【従来の技術】CD-ROMのように半導体レーザを用いて情報を読み出す約1.2mmの厚さの光ディスクが提供されている。この種の光ディスクではピックアップ用対物レンズにフォーカスサーボ及びトラッキングサーボを行うことにより、信号記録面のピット列にレーザビ 30-ムを照射させ、信号を再生している。また、最近では長時間の動画を記録するための高密度化が進んでいる。

【0003】例えば、CD-ROMと同じ直径 12cm の光ディスクに、片面で 4.7Gbyte の情報を記録する DVD 規格が提案されている。 DVD のディスク厚は約0.6mm であり、これを両面貼り合わせることにより、 1 枚で 9.4Gbyte の情報を記録できる。また、直径、基板厚、記録密度が CD と同じである追記可能な光ディスクとして CD-R もある。

【0004】今度、これら3種類の光ディスクの併存が 40 考えられるため3種類の光ディスクを互換再生できる装置が必要である。DVDとCD、CD-Rではディスク基板の厚みが異なるため1つの光ピックアップで両者を再生できない。そこで、特開平5-303766号公報には、厚さ0.6mmの薄型基板を有する高密度の光ディスクと、厚さ1.2mmの標準厚の基板を有する標準密度の光ディスクとを、1個の光ピックアップによって再生できるようにする装置が提案されている。

【0005】この技術は短波長のレーザビームにて高密 たは/および再生を行う光ピックアップ装置であって、 度のディスクを再生すべく設計された開口数0.6の対 50 記録または/および再生が行われるべき光ディスクに対

物レンズを用い、標準厚で標準密度の光ディスクを再生する場合に、収差補正手段にレーザビームの外周側を遮光して実効的な開口数を減少させるアパーチャを付加したものを対物レンズの光源側に介挿する装置である。また、半導体レーザから出射されるレーザビームの外周部を選択的に遮光してレーザビームを集光する対物レンズの実効的開口数を変更する方法として出願人は、特願平8-84307号においてレーザビームの偏光面を選択的に回転する液晶と特定方向に偏光するレーザビームのみを透過させる偏光フィルタを組み合わせる方法を提案し、この方法を用いて基板厚の異なる光ディスクを互換再生できる技術を開示している。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】特願平8-84307号に開示された方法では、基板厚の異なるDVDとCDとの互換再生は可能であるが、基板厚が1.2mmのCD-Rを波長635nmのレーザビームで再生することができない。また、信号がピット列として記録されるため、ピットの大きさに応じて信号記録面に照射されるビクム径を変える必要もあり、DVDと、DVDのピットより更に小さいピットで記録される高密度DVDとを波長635nmのレーザビームを用いて互換再生することができない。

【0007】そこで、本発明は、かかる問題点を解決し、基板厚が0.6mmのDVDと基板厚が1.2mmのCD、CD-Rとの互換再生、およびDVDと高密度DVDとの互換再生が可能な光ピックアップ装置を提供するものである。

[0008]

【課題を解決するための手段】本発明は、第1の厚さの 透明基板を有する第1の光ディスク、および第1の厚さ と異なる第2の厚さの透明基板を有する第2の光ディス クの記録または/および再生を行う光ピックアップ装置 であって、記録または/および再生が行われるべき光デ ィスクに対向して設けられた対物レンズと、記録または /および再生が行われるべき光ディスクの透明基板の厚 さに応じて対物レンズの開口数を変更する開口数変更手 段と、第1の波長を持つ第1のレーザ光と、第1の波長 と異なる第2の波長を持つ第2のレーザ光とを選択的に 生成し、その生成された第1のレーザ光を第1の方向に 回折させ、第2のレーザ光を第1の方向と異なる第2の 方向に回折させ、回折させたレーザ光を対物レンズに導 き、第1のレーザ光、および第2のレーザ光の光ディス クの信号記録面からの反射光を検出する光学手段とを含 むことを特徴とする。

【0009】また、本発明は、第1の厚さの透明基板を有する第1の光ディスク、および第1の厚さと異なる第2の厚さの透明基板を有する第2の光ディスクの記録または/および再生を行う光ピックアップ装置であって、

向して設けられた対物レンズと、記録または/および再 生が行われるべき光ディスクの透明基板の厚さに応じて 対物レンズの開口数を変更する開口数変更手段と、第1 の波長を持つ第1のレーザ光と、第1の波長と異なる第 2の波長を持つ第2のレーザ光とを選択的に生成し、第 1のレーザ光、および第2のレーザ光の前記光ディスク の信号記録面からの反射光を検出する光学手段と、光学 手段からの第1のレーザ光を第1の方向に回折させ、第 2のレーザ光を第1の方向と異なる第2の方向に回折さ せ、その回折させたレーザ光を対物レンズに導くととも に、第1のレーザ光、および第2のレーザ光の光ディス クの信号記録面からの反射光を光学手段に導くホログラ ムとを含むことを特徴とする。。

【0010】また、本発明は、更に、第1の厚さの透明 基板を有する第1の光ディスク、および第1の厚さと異 なる第2の厚さの透明基板を有する第2の光ディスクの 記録または/および再生を行う光ピックアップ装置であ って、記録または/および再生が行われるべき光ディス クに対向して設けられた対物レンズと、記録または/お よび再生が行われるべき光ディスクの透明基板の厚さに 20 応じて対物レンズの開口数を変更する開口数変更手段 と、第1の波長を持つ第1のレーザ光と、第1の波長と 異なる第2の波長を持つ第2のレーザ光とを選択的に生 成し、その生成された第1のレーザ光を第1の方向に回 折させ、第2のレーザ光を第1の方向と異なる第2の方 向に回折させるとともに、第1のレーザ光、および第2 のレーザ光の光ディスクの信号記録面からの反射光を検 出する光学手段と、光学手段からの第1のレーザ光、お よび第2のレーザ光を受け、その受けたレーザ光を対物 レンズに導くコリメータレンズとを含むことを特徴とす る。

【0011】また、本発明は、更に、第1の厚さの透明 基板を有する第1の光ディスク、および第1の厚さと異 なる第2の厚さの透明基板を有する第2の光ディスクの 記録または/および再生を行う光ピックアップ装置であ って、記録または/および再生が行われるべき光ディス クに対向して設けられた対物レンズと、記録または/お よび再生が行われるべき光ディスクの透明基板の厚さに 応じて対物レンズの開口数を変更する開口数変更手段 と、第1の波長を持つ第1のレーザ光と、第1の波長と 40 異なる第2の波長を持つ第2のレーザ光とを選択的に生 成し、第1のレーザ光、および第2のレーザ光の光ディ スクの信号記録面からの反射光を検出する光学手段と、 レーザ光生成手段から第1のレーザ光、および第2のレ ーザ光を受け、その受けた光を対物レンズに導くコリメ ータレンズと、コリメータレンズの直前または直後に設 けられ、第1のレーザ光を第1の方向に回折させ、第2 のレーザ光を第1の方向と異なる第2の方向に回折させ るとともに、第1のレーザ光、および第2のレーザ光の 光ディスクの信号記録面からの反射光を光学手段に導く 50 m、最短ピット長が0.83(許容範囲:0.80~0.

ホログラムとを含むことを特徴とする。

【0012】また、本発明は、更に、好ましくは、ホロ グラムがコリメータレンズと一体的に設けられているこ とを特徴とする。また、本発明は、更に好ましくは、光 学手段が第1のレーザ光を生成する第1の半導体レーザ と、第2のレーザ光を生成する第2の半導体レーザと、 第1のレーザ光、および第2のレーザ光の光ディスクの 信号記録面からの反射光を検出する光検出手段と、第1 の半導体レーザにより生成された第1のレーザ光を第1 の方向に回折させ、第2の半導体レーザにより生成され た第2のレーザ光を第1の方向と異なる第2の方向に回 折させるとともに、第1のレーザ光、および第2のレー ザ光の光ディスクの信号記録面からの反射光を光検出手 段に導くホログラムとを含むことを特徴とする。

【0013】また、本発明は、更に好ましくは、第1の 半導体レーザと第2の半導体レーザは、第1のレーザ 光、および第2のレーザ光の信号記録面からの反射光が 光検出手段の同じ位置で検出されるように配置されてい ることを特徴とする。また、本発明は、更に好ましく は、第2の半導体レーザは、第1の半導体レーザに対し て光ディスクの外径方向に配置されていることを特徴と する。

【0014】また、本発明は、更に好ましくは、第1の 半導体レーザと第2の半導体レーザとは、光ディスクの 円周方向に配置されていることを特徴とする。また、本 発明は、更に好ましくは、第1の半導体レーザと第2の 半導体レーザとの距離を 2。第1の半導体レーザと光検 出手段との距離を21、第2の半導体レーザと光検出手段 との距離をZ1、第1の半導体レーザとホログラムとの距 離をL、ホログラムのピッチをp、第1のレーザ光の波 長をλ,、第2のレーザ光の波長をλ,とした場合に、 $Z_1 = L \lambda_1 / (p^2 - \lambda_1^2)^{1/2}, Z_2 = L \lambda_2 / (p^2 - \lambda_2^2)$

2₀=2,-2,なる関係を有することを特徴とする。 [0015]

【発明の実施の形態】

第1の実施の形態

図を参照しつつ、本発明の第1の実施の形態を説明す る。図18に本発明が互換再生の対象とするCD、CD - R及びDVDの定格値と再生条件を示す。 CDの基板 厚は1.2 (許容誤差±0.1) mm、最短ピット長が 0.83 (許容範囲: 0.80~0.90) μm、トラッ クピッチが 1.6 (許容誤差± 0.1) μ mであり、反射 率は波長780nmのレーザビームに対して60~70 %以上である。また、再生時のレーザビームのスポット 径は1.5(許容誤差±0.1) μ m、対物レンズの開口 数は0.45 (許容誤差±0.05)、再生レーザビーム 波長が780 (許容範囲:760~800) nmであ る。CD-Rの基板厚は1.2 (許容誤差±0.1) m

10

90) μm、トラックピッチが1.6 (許容誤差±0. 1) μm、波長780 nmのレーザピームに対する反射 率が60~70%以上であり、再生時のレーザビームの スポット径が 1.5 (許容誤差±0.1) μm、対物レン ズの開口数が0.45 (許容誤差±0.05)、再生レー ザビーム波長が780 (許容範囲:760~800) n mである。一方、DVDの基板厚は0.6 (許容誤差± 0.05) mm、最短ピット長が0.40 (許容誤差± 0.1) μm、トラックピッチが0.74 (許容誤差± 0.01) μm、波長635nmのレーザピームに対す る反射率が40%以上(単一の信号記録面の場合)若し くは15~40%(信号記録面が2つの場合)であり、 再生時のレーザビームのスポット径が0.9 (許容誤差 ±0.5) μm、対物レンズの開口数が0.6 (許容誤差 ±0.05)、再生レーザビーム波長が635(許容範 囲:620~660) nmである。

【0016】CD、CD-RとDVDとの互換再生を行 う光ピックアップ10の構成を図1に示す。光学手段1 中の半導体レーザ1a、1bから発せられた波長635 (許容範囲:620~660) nm若しくは波長780 (許容範囲: 760~800) nmのレーザピームは光 学手段1の表面に設けられたホログラム1 dで選択的に 回折され、開口数変更手段4で選択的に遮光されて対物 レンズ5に入射する。該対物レンズ5で集光されたレー ザビームは、透光性のポリカーボネートの基板7 (また は77)を通って光ディスクの信号記録面7a(または 77a) に照射される。該信号記録面7a (または77 a) で反射されたレーザビームは前記基板 7 (または 7 7)、前記対物レンズ5、前記開口数変更手段4を介し て戻り、前記ホログラム1dを介して前記光学手段1中 30 に設置された光検出器1 c で検知される。前記対物レン ズ5は基板厚0.6mmの光ディスク用に設計されてお り、開口数は0.6 (許容誤差±0.05) である。

【0017】本発明においては、前記光学手段1は波長780nmのレーザビームを発する半導体レーザ1a、波長635nmのレーザビームを発する半導体レーザ1b、光検出器1c及び波長635nmのレーザビームは回折せず、波長780nmのレーザビームのみを回折するホログラム1dを配しており、CD、CD-Rが再生される場合には前記半導体レーザ1aが選択駆動され、DVDが再生される場合には前記半導体レーザ1bが選択駆動される。即ち、光学手段1は、波長635nmのレーザビームと波長780nmのレーザビームとを選択駆動し、波長780nmのレーザビームのみを回折して前記対物レンズ4に入射させるとともに、波長635nmのレーザビーム、および波長780nmのレーザビームの光ディスクの信号記録面での反射光を前記光検出器1cに集光する機能を有するものである。

【0018】また、前記開口数変更手段4は外周部4a と内周部4bとに分割されており、内周部4bは波長6 50

35 nmのレーザビーム、および波長780 nmのレーザビームをそのまま透過するが、外周部4aは波長780 nmのレーザビームのみを遮光する機能を有するものである。内周部4bの直径は波長780 nmのレーザビームの前記対物レンズ5での実効的開口数が0.45

(許容誤差±0.05)となる直径である。また、前記 開口数変更手段4と前記対物レンズ5とはアクチュエータ6に固定されているため、開口数変更手段4はフォーカス引き込み時、トラッキングサーボ時に前記対物レンズ5に連動して移動する。この結果、開口数変更手段4と対物レンズ5との位置ずれはなく、波長780nmのレーザビームの外周部を確実に遮光できる。

【0019】また、前記光学手段1中には、前記半導体 レーザ1a、1bと前記光検出器1cとが設けられてい るが、これらの位置関係について説明する。本発明で用 いるホログラムは半導体レーザから発せられたレーザビ ームの波長の違いにより選択的にレーザビームを回折 し、前記対物レンズ5に入射させ、前記信号記録面7a (または77a) からの反射光を、レーザピームを発し た半導体レーザの方向とは異なる方向に集光させる機能 を有するものである。図2を参照して、レーザビームを 発する半導体レーザSLと反射光を検出する光検出器D との位置関係の決定方法について説明する。半導体レー ザSLと光検出器Dとは同一平面上に設置されており、 半導体レーザSLとホログラムHとの距離をL、ホログ ラムHに設けられた微少な凹凸構造のピッチをp、反射 光がホログラムHにより変更された進行方向と法線方向 との成す角を θ 、レーザビームの波長を λ 、半導体レー ザSLと光検出器Dとの距離をZとする。

【0020】この場合、

s i n $\theta = \lambda / p \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (1)$

 $Z = L t a n \theta \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (2)$ が成立する。また、上記、式(1)、(2)より $Z = L \lambda / (p^i - \lambda^i)^{1/i} \cdots (3)$ が成立する。従って、レーザビームの波長が長い程、反 射光がホログラムΗにより進行方向を変えられる角度θ は大きくなる。その結果、半導体レーザSLと光検出器 Dとの距離 Z は大きくなる。これは、波長の異なるレー ザビームを発する半導体レーザを同一の位置に設置した ならば、反射光を検出する位置が異なることを意味す る。即ち、波長635nmのレーザビームの反射光が光 検出器Dで検出されるならば、波長780nmのレーザ ビームの反射光は光検出器Dより半導体レーザSLとは 反対方向にずれた位置で検出できることになる。そこ で、本発明においては、レーザビームの波長の相違に起 因して発生する反射光の検出位置のずれを半導体レーザ の設置位置を相違させることにより吸収し、波長が異な ってもレーザビームの反射光を同じ位置で検出できるよ うに2つの半導体レーザと光検出器とを設置したことを

1つの特徴としている。また、半導体レーザSLと光検

出器Dとの距離Zは半導体レーザSLとホログラムHと の距離しによっても変化するので、図3を参照して、本 発明における前記ホログラム1 d、前記半導体レーザ1 a、1b及び前記光検出器1cの詳細な位置関係につい て説明する。波長635nmのレーザビームを発する半 導体レーザ1bと光検出器1cとの距離を2..波長78 0 nmのレーザビームを発する半導体レーザ1 aと光検 出器1 c との距離を Z, として Z, 〉 Z, となるように半 導体レーザ1a、1b、光検出器1cを設置する。ホロ グラム1 d の凹凸構造のピッチ p と、半導体レーザ1 a. 1b、光検出器1cとホログラム1dとの距離、即 ち、レーザビームの発光点とホログラムとの距離Lとを パラメータとしてZ1、Z2、Z2一Z1を計算した結果を 図4に示す。ホログラムのピッチpが1.5~35 μm の範囲、レーザビームの 発光点とホログラム間の距離 Lが3~25mmの範囲でZ₂-Z₁が0.1~0.5 m mの範囲となる。また、前記半導体レーザ1bと前記光 検出器1cとの距離は0.5~2.2mmの範囲となる。 従って、本発明においては、半導体レーザ1 a と半導体 レーザ1bとの距離を0.1~0.5mmの範囲に設定し て設置し、波長635nmのレーザビームと波長780 nmのレーザビームの光ディスクの信号記録面からの反 射光を前記光検出器1cの同一位置で検出する。この場 合、半導体レーザ1bを中心にして半導体レーザ1aが 光ディスクの外周方向に位置するように、光検出器1 c が光ディスクの内周方向に位置するように配置されてい

【0021】また、半導体レーザ1aと半導体レーザ1 bとは $0.1 \sim 0.5 \, \text{mm}$ の範囲で設置位置が異なるが、 この範囲のずれは光ディスクに照射されるレーザビーム 30 段46を透過するが、波長780nmのレーザビームは の光軸のずれによる再生特性の劣化として現れることは ない。また、更に、前記半導体レーザ1aと前記半導体 レーザ1 b との設置位置の方向は光ディスクの径方向に 限らず、周方向であってもよい。

【0022】図5を参照して、前記半導体レーザ1a、 1 bと前記光検出器1 c のマウントについて説明する。 図5は前記開口数変更手段4側から見た図を示してい る。光学手段1には3つの切り込みk1, k2, k3が あり半導体レーザ1a、1bのそれぞれの発光点A、B が切り込み k 2 - k 3 を結ぶ線上に横方向に並ぶように 40 マウントされている。2つの半導体レーザ1a、1bが マウントされた光学手段1は切り込みk2-k3方向が 光ディスクの径方向、即ち、トラッキング方向と一致す るように設置されている。また、半導体レーザ1a、1 bは独立に作成し、素子を1つの基板上にマウントして も良く、1つの基板上で結晶成長を行い、2つの素子を 作成しても良い。

【0023】図6を参照して、前記開口数変更手段4の 具体例について説明する。図6に示す開口数変更手段4 4は外周部44aは波長635nmのレーザビームを、

そのまま、全面的に透過し、波長780nmのレーザビ ームのみを光軸の外側に回折し、前記対物レンズ5に入 射させない機能を有し、内周部44bは波長635nm のレーザピーム、および波長780nmのレーザビーム をそのまま透過させる。図6(a)を参照して、波長6 35 nmのレーザピーム50は開口数変更手段44によ り何ら影響を受けず、そのまま透過する。一方、図6 (b) を参照して、波長780 nmのレーザピーム51 は開口数変更手段44においては、内周部44bに入射 するレーザビームはそのまま透過するが、外周部44a に入射するレーザビームは光軸の外側に大きく回折を受 ける。その結果、実質的に内周部のみが透過したレーザ ピーム52となる。

【0024】また、図7を参照して、前記開口数変更手 段4の他の具体例について説明する。図7に示す開口数 変更手段45は外周部45aに紙面に垂直な方向に偏光 するレーザピームのみを透過する偏光フィルムを設け、 内周部45 bには何も設けないものである。その結果、 紙面に垂直な方向に偏光する波長635nmのレーザビ ームは全面的に開口数変更手段45を透過するが、紙面 に平行な方向に偏光する波長780nmのレーザビーム は外周部のみが開口数変更手段45により遮光され、内 周部のみが透過する。

【0025】また、図8を参照して、前記開口数変更手 段4の更に他の具体例を説明する。図8に示す開口数変 更手段46は外周部46aに波長780nmのレーザビ ームのみを吸収する偏光ガラスを設け、内周部46bは 偏光ガラスを設けない通常のガラスである。その結果、 波長635nmのレーザビームは全面的に開口数変更手 外周部のみが開口数変更手段46により遮光され、内周 部のみが透過する。

【0026】図9を参照して、基板厚0.6mmの光デ ィスクであるDVDの再生動作について説明する。DV Dが再生される場合には、後述する光再生装置中のレー ザ駆動回路18により光学手段1中の波長635nmの レーザビームを発する半導体レーザ1 aが選択駆動され る。その結果、波長635nmのレーザビームは前記ホ ログラム1d、前記開口数変更手段4をそのまま透過 し、対物レンズ5で集光されて光ディスクの基板7を通 って信号記録面7 aに照射される。信号記録面7 aに照 射されるレーザビームのスポット径は0.9 (許容誤差 ±0.1) μmである。その後の動作については図1の 説明と同じであるので省略する。

【0027】図10を参照して、基板厚1.2mmの光 ディスクであるCD、CD-Rの再生動作について説明 する。CD、CD-Rが再生される場合には、前記レー ザ駆動回路18により光学手段1中の波長780nmの レーザビームを発する半導体レーザ1 bが選択駆動され 50 る。その結果、波長780nmのレーザピームは前記ホ

ログラム1dで回折を受け、前記開口数変更手段4で外 周部のみが遮光され、内周部が前記対物レンズ 5 に入射 する。対物レンズ5に入射したレーザビームは集光され

て光ディスクの基板 7 7 を通って信号記録面 7 7 a に照 射される。信号記録面77aに照射されるレーザピーム のスポット径は1.5 (許容誤差 ± 0.1) μ mである。 その後の動作については図1の説明と同じであるので省 略する。 [0028]尚、この場合、前記開口数変更手段4によ

り外周部を遮光されたレーザビームの内周部は、前記ホ 10 ログラム1 dによる回折の効果により遮光後も外側に回 折されて前記対物レンズ5に入射し、対物レンズ5によ り集光される結果、基板厚1.2mmの光ディスクでの 収差の発生は抑えられる。また、本発明における光ピッ クアップは図1に示すものに限らず図11に示すもので あってもよい。即ち、図1に示す構成では半導体レーザ 1 a、1 b、光検出器1 c 及びホログラム1 d は1つの 光学手段1中に配置されていたが、これに限らず、図1 1に示すようにホログラム2が光学手段1と分離した構 成の光ピックアップ20であってもよい。この場合、光 20 学手段1中の半導体レーザ1a、1bとホログラム2と の距離、半導体レーザ1aと半導体レーザ1bとの距 離、半導体レーザ1 bと光検出器1 c との距離、ホログ ラム2のピッチは図4に示したものと同じである。ま た、光学手段1とホログラム2以外の構成要素は図1と 同じであるので、その機能の説明についても省略する。 【0029】また、本発明における光ピックアップは、 更に、図12に示す構成のものであってもよい。図12 に示す光ピックアップ40は図1に示す光ピックアップ 10の前記光学手段1と前記開口数変更手段4との間に 30 コリメータレンズ3を挿入した構成である。光学手段1 中の半導体レーザ1a、1bとホログラム1dとの距 離、半導体レーザlaと半導体レーザlbとの距離、半 導体レーザ1bと光検出器1cとの距離、ホログラム1 dのピッチは図4に示したものと同じである。それ以外

【0030】また、本発明における光ピックアップは、 更に、図13から16に示す構成のものであってもよ い。図13から16に示す光ピックアップは、図1の光 40 ピックアップ10においてホログラム2が光学手段1と 分離し、コリメータレンズ3が追加になった構成であ る。この場合においても光学手段1中の半導体レーザ1 a、1bとホログラム2との距離、半導体レーザ1aと 半導体レーザ1 b との距離、半導体レーザ1 b と光検出 器1cとの距離、ホログラム2のピッチは図4に示した ものと同じである。また、ホログラム2は、図13に示 すようにコリメタレンズ3の手前にあってもよく、図1 4に示すようにコリメータレンズ3の直後にあってもよ い。また、更に、ホログラム2はコリメータレンズ3と 50

は光ピックアップ10と同じであるので、その他の説明

については省略する。

一体になっていてもよく、この場合も図15、16に示 すようにコリメータレンズ3の手前側、後側の表面にホ

14

ログラム2が設けられていてもよい。図17を参照し て、基板厚が 0.6 mmのDVDと基板厚が 1.2 mmの CD、CD-Rを互換再生する再生装置について説明す る。光ピックアップ10中の対物レンズ5はサーボ機構 13により再生しようとしている信号がピット列として 形成されているトラックにレーザビームを集光するよう に制御されており、レーザピームは前記対物レンズ5に より集光され、光ディスクの基板? (又は??) を通っ て信号記録面7a(又は77a)に照射される。該信号 記録面7a(又は77a)で反射されたレーザビームは 光検出器1cで検知され、再生信号として検出される。 前記光検出器1cで検出された再生信号はブリアンブ1 1へ送られ、所定の増幅が行われた後、判別回路14と RF復調回路16及びサーボ回路12に送られる。サー ボ回路12は送られてきたトラッキングエラー信号に基 づき前記サーボ機構13を制御する。また、判別回路1 4は、送られてきた信号に基づいて再生装置に装着され た光ディスクの種類を識別し、識別結果を指令回路15 に送る。該指令回路15は、識別した光ディスクに適合 するように前記光学手段1中の半導体レーザを切り替え るために、送られてきた識別結果に基づいて制御回路1 9に指令を出す。また、前記指令回路15は、識別した 光ディスクの再生に適合する復調回路に切り替えるため に、送られてきた識別結果に基づいて特性切替回路17 にも指令を出す。前記制御回路19は、前記指令回路1 5からの指令に基づいてレーザ駆動回路18を介して半 導体レーザを切り換え、前記特性切替回路17は、前記 指令回路15からの指令に基づいて、RF復調回路16 を切り替える。これにより、再生装置に装着された光デ ィスクに適した再生が行われる。

第2の実施の形態

上記第1の実施の形態においては、波長635nmのレ ーザビームと波長780nmのレーザビームを選択的に 生成する光学手段1を用いて基板厚0.6mmの光ディ スクであるDVDと基板厚1.2mmの光ディスクであ るCD、CD-Rとを互換再生できる光ピックアップ装 置について説明したが、本第2の実施の形態は、波長4 80 (許容範囲: 350~550) nmのレーザビーム と波長635 (許容範囲:620~660) nmのレー ザビームとを選択的に生成する光学手段を用いてDVD と高密度DVDとを互換再生する光ピックアップ装置に ついて示すものである。

【0031】図19を参照して、本発明が対象とするD VDと高密度DVDの定格値と再生条件を説明する。 D VDの基板厚は0.6 (許容誤差±0.05) mm、最短 ピット長が 0.40 (許容誤差±0.1) μm、トラック ピッチが 0.74 (許容誤差±0.01) μm、波長 63 5 nmのレーザピームに対する反射率が40%以上(単

-の信号記録面の場合)若しくは15~40%(信号記録面が2つの場合)であり、再生時のレーザピームのスポット径が0.9(許容誤差±0.5)μm、対物レンズの開口数が0.6(許容誤差±1.5)nmである。一方、高密度DVDの基板厚は0.3(許容誤差±0.05)mm、最短ピット長が0.30(許容誤差±0.1)μm、トラックピッチが0.56(許容誤差±0.1)μm、トラックピッチが0.56(許容誤差±0.01)μm、波長480nmのレーザピームに対する反射率が40%以上(単一の信号記録面の場合)若しくは15~1040%(信号記録面が2つの場合)であり、再生時のレーザピームのスポット径が0.7(許容誤差±0.5)μm、対物レンズの開口数が0.65(許容誤差±0.05)、再生レーザピーム波長が480(許容範囲:350~550)nmである。

【0032】DVDと高密度DVDとの互換再生を行う 光ピックアップ201の構成を図20に示す。光学手段 202中の半導体レーザ1e、1bから発せられた波長 480 (許容範囲: 350~550) nm若しくは波長 635 (許容誤差±15) nmのレーザビームは光学手 段202の表面に設けられたホログラム1gで選択的に 回折され、開口数変更手段203で選択的に遮光されて 対物レンズ204に入射する。該対物レンズ204で集 光されたレーザビームは、透光性のポリカーボネートの 基板205 (または206) を通って光ディスクの信号 記録面205a (または206a) に照射される。該信 号記録面205a(または206a)で反射されたレー ザビームは前記基板205 (または206)、前記対物 レンズ204、前記開口数変更手段203を介して戻 り、前記ホログラム1gを介して前記光学手段202中 30 に設置された光検出器1 c で検知される。前記対物レン ズ204は基板厚0.3mmの光ディスク用に設計され ており、開口数は0.65 (許容誤差±0.05) であ

【0033】本発明においては、前記光学手段202は 波長635nmのレーザビームを発する半導体レーザ1 b、波長480nmのレーザビームを発する半導体レーザ1e、光検出器1c及び波長480nmのレーザビームのみを回 折するホログラム1gを配しており、DVDが再生され 40 る場合には前記半導体レーザ1bが選択駆動され、高密度DVDが再生される場合には前記半導体レーザ1eが 選択駆動される。即ち、光学手段202は波長480nmのレーザビームと波長635nmのレーザビームとを 選択駆動し、波長635nmのレーザビームのみを回折して前記対物レンズ204に入射させるとともに、波長480nmのレーザビーム、および波長635nmのレーザビームの光ディスクの信号記録面での反射光を前記 光検出器1cに集光する機能を有するものである。

【0034】また、前記開口数変更手段203は外周部 50

203aと内周部203bとに分割されており、内周部203bは波長480nmのレーザビーム、および波長635nmのレーザビームをそのまま透過するが、外周部203aは波長635nmのレーザビームのみを遮光する機能を有するものである。内周部203bの直径は波長635nmのレーザビームの前記対物レンズ204での実効的開口数が0.60(許容誤差±0.05)となる直径である。また、前記開口数変更手段203と前記対物レンズ204とはアクチュエータ6に固定されているため、開口数変更手段203はフォーカス引き込み時、トラッキングサーボ時に前記対物レンズ204に連動して移動する。この結果、開口数変更手段203と対物レンズ204との位置ずれはなく、波長635nmのレーザビームの外周部を確実に遮光できる。

【0035】また、前記光学手段202中には、前記半 導体レーザ1b、1eと前記光検出器1cとが設けられ ているが、これらの位置関係の決定方法は、上記第1の 実施の形態中の図2、3において説明した方法と同じ方 法である。波長480nmのレーザピームを発する半導 20 体レーザ1 e と光検出器1 c との距離を2, 波長635 nmのレーザピームを発する半導体レーザ1bと光検出 器1cとの距離を2,として2,〉2,となるように半導 体レーザ1 e、1 b、光検出器1 c を設置する。ホログ ラム1gの凹凸構造のピッチpと、半導体レーザ1e, 1 b、光検出器1 c とホログラム1 g との距離、即ち、 レーザピームの発光点とホログラムとの距離しとをパラ メータとして Z₁, Z₁, Z₁—Z₁ を計算した結果を図21 に示す。 ホログラムのピッチpが3~12μmの範 囲、レーザビームの発光点とホログラム間の距離しが3 ~15mmの範囲でZ₁一Z₁が0.1~0.5mmの範囲 となる。また、前記半導体レーザ1 e と前記光検出器 1 c との距離は 0.289~1.45 mmの範囲となる。 従って、本発明においては、半導体レーザ1eと半導体 レーザ1bとの距離を0.1~0.5mmの範囲に設定し て設置し、波長480nmのレーザビームと波長635 nmのレーザピームの光ディスクの信号記録面からの反 射光を前記光検出器1 c の同一位置で検出する。この場 合、半導体レーザ1 e を中心にして半導体レーザ1 b が 光ディスクの外周方向に位置するように、光検出器1c が光ディスクの内周方向に位置するように配置されてい る。

【0036】また、半導体レーザ1 bと半導体レーザ1 eとは0.1~0.5 mmの範囲で設置位置が異なるが、この範囲のずれは光ディスクに照射されるレーザビームの光軸のずれによる再生特性の劣化として現れることはない。また、更に、前記半導体レーザ1 bと前記半導体レーザ1 e との設置位置の方向は光ディスクの径方向に限らず、周方向であってもよい。

【0037】また、更に、前記半導体レーザ1b、1e と前記光検出器1cのマウントについては上記第1の実

施の形態中の図5に示すマウントと同じである。また、 更に、前記開口数変更手段203の具体例としては、上 記第1の実施の形態中の図6、7、8に示す具体例が本 第2の実施の形態の前記開口数変更手段203にも使用 できる。

【0038】基板厚0.6mmのDVDと基板厚0.3m mの高密度DVDとの再生動作は上記第1の実施の形態 中の図9、10で説明した動作と同様である。また、本 第2の実施の形態における光ピックアップ装置は、前記 光ピックアップ201の構成に限らず、図22に示すも 10 のであってもよい。即ち、図20に示す構成では半導体 レーザ1b、1e、光検出器1c及びホログラム1gは 1つの光学手段202中に配置されていたが、これに限 らず、図22に示すようにホログラム207が光学手段 202と分離した構成の光ピックアップ221であって もよい。この場合、光学手段202中の半導体レーザ1 b、1eとホログラム207との距離、半導体レーザ1 bと半導体レーザ1eとの距離、半導体レーザ1eと光 検出器1cとの距離、ホログラム207のピッチは図2 1に示したものと同じである。また、光学手段202と 20 ホログラム207以外の構成要素は図20と同じである ので、その機能の説明についても省略する。

【0039】また、本第2の実施の形態における光ピッ クアップは、更に、図23に示す構成のものであっても よい。図23に示す光ピックアップ231は図20に示 す光ピックアップ201の前記光学手段202と前記開 口数変更手段203との間にコリメータレンズ208を 挿入した構成である。光学手段202中の半導体レーザ 1 b、1 e とホログラム1 g との距離、半導体レーザ1 検出器1cとの距離、ホログラム1gのピッチは図21 に示したものと同じである。それ以外は光ピックアップ 201と同じであるので、その他の説明については省略 する。

【0040】また、本発明における光ピックアップは、 更に、図24から27に示す構成のものであってもよ い。図24から27に示す光ピックアップは、図20の 光ピックアップ201においてホログラム207が光学 手段202と分離し、コリメータレンズ208が追加に なった構成である。この場合においても光学手段202 40 中の半導体レーザ1b、1eとホログラム207との距 離、半導体レーザ1 bと半導体レーザ1 e との距離、半 導体レーザ1eと光検出器1cとの距離、ホログラム2 07のピッチは図21に示したものと同じである。ま た、ホログラム207は、図24に示すようにコリメー タレンズ208の手前にあってもよく、図25に示すよ うにコリメータレンズ208の直後にあってもよい。ま た、更に、ホログラム207はコリメータレンズ208 と一体になっていてもよく、この場合も図26、27に

面にホログラム207が設けられていてもよい。

【0041】基板厚が0.6mmのDVDと基板厚が0. 3mmの高密度DVDを互換再生する再生装置は、上記 第1の実施の形態中の図17に示した装置と同じ再生装 置を使用できる。

第3の実施の形態

本第3の実施の形態においては、基板厚1.2 (許容誤 差±0.1) mmの光ディスクであるCD、CD-Rと 基板厚 0.3 (許容誤差±0.05) mmの光ディスクで ある高密度DVDとの互換再生について説明する。

【0042】図28に本第3の実施の形態における光ピ ックアップ装置が互換再生の対象とするCD、CD-R 及び高密度DVDの定格値と再生条件を示す。CDの基 板厚は1.2 (許容誤差±0.1) mm、最短ピット長が 0.83 (許容範囲: 0.80~0.90) μm、トラッ クピッチが 1.6 (許容誤差±0.1) μ mであり、反射 率は波長780nmのレーザビームに対して70%以上 である。また、再生時のレーザビームのスポット径は 1.5 (許容誤差±0.1) μm、対物レンズの開口数は 0.45(許容誤差±0.05)、再生レーザビーム波長 が780 (許容範囲:760~800) nmである。C D-Rの基板厚は1.2 (許容誤差±0.1) mm、最短 ピット長が0.83 (許容範囲: 0.80~0.90) μ m、トラックピッチが 1.6 (許容誤差± 0.1) μm 、 波長780nmのレーザピームに対する反射率が60~ 70%以上であり、再生時のレーザビームのスポット径 が1.5 (許容誤差±0.1) μm、対物レンズの開口数 が 0.45 (許容誤差±0.05)、再生レーザピーム波 長が780 (許容範囲:760~800) nmである。 bと半導体レーザ1eとの距離、半導体レーザ1eと光 30 一方、高密度DVDの基板厚は0.3 (許容誤差±0.0 5) mm、最短ピット長が0.30 (許容誤差±0.1) μm、トラックピッチが 0.56 (許容誤差± 0.01) μm、波長480nmのレーザピームに対する反射率が 40%以上(単一の信号記録面の場合) 若しくは15~ 40%(信号記録面が2つの場合)であり、再生時のレ ーザビームのスポット径が0.9(許容誤差±0.5) μ m、対物レンズの開口数が 0.6 (許容誤差± 0.0 5) 、再生レーザピーム波長が480 (許容範囲:35 0~550) nmである。

【0043】CD、CD-Rと高密度DVDとの互換再 生を行う光ピックアップ291の構成を図29に示す。 光学手段292中の半導体レーザ1e、1aから発せら れた波長480 (許容範囲:350~550) nm若し くは波長635 (許容範囲:620~660) nmのレ ーザビームは光学手段292の表面に設けられたホログ ラム1hで選択的に回折され、開口数変更手段293で 選択的に遮光されて対物レンズ294に入射する。該対 物レンズ294で集光されたレーザビームは、透光性の ポリカーボネートの基板295(または296)を通っ 示すようにコリメータレンズ208の手前側、後側の表 50 て光ディスクの信号記録面295a(または296a)

20

に照射される。該信号記録面295a(または296a)で反射されたレーザビームは前記基板295(または296)、前記対物レンズ294、前記開口数変更手段293を介して戻り、前記ホログラム1hを介して前記光学手段292中に設置された光検出器1cで検知される。前記対物レンズ294は基板厚0.6mmの光ディスク用に設計されており、開口数は0.60(許容誤差±0.05)である。

【0044】本発明においては、前記光学手段292は 被長780nmのレーザビームを発する半導体レーザ1 a、被長480nmのレーザビームを発する半導体レーザ1e、光検出器1c及び被長480nmのレーザビームのみを回折するホログラム1hを配しており、CD、CD-Rが再生される場合には前記半導体レーザ1aが選択駆動され、高密度DVDが再生される場合には前記半導体レーザ1eが選択駆動される。即ち、光学手段292は被長480nmのレーザビームと被長780nmのレーザビームのみを回折して前記対物レンズ294に入射させるともに、波長480nmのレーザビーム、および波長780nmのレーザビームの光ディスクの信号記録面での反射光を前記光検出器1cに集光する機能を有するものである。

【0046】また、前記光学手段292中には、前記半 40 導体レーザ1a、1eと前記光検出器1cとが設けられているが、これらの位置関係の決定方法は、上記第1の実施の形態中の図2、3において説明した方法と同じ方法である。波長480nmのレーザピームを発する半導体レーザ1eと光検出器1cとの距離をZ, 波長780nmのレーザピームを発する半導体レーザ1aと光検出器1cとの距離をZ,としてZ, Z,となるように半導体レーザ1e、1a、光検出器1cを設置する。ホログラム1hの凹凸構造のピッチpと、半導体レーザ1e, 1a、光検出器1cとホログラム1hとの距離、即ち、50

レーザピームの発光点とホログラムとの距離しとをパラ メータとして Z₁, Z₁, Z₁-Z₁を計算した結果を図30 に示す。 ホログラムのピッチpが5~12μmの範 囲、レーザビームの発光点とホログラム間の距離Lが2 ~15mmの範囲でZ₁ — Z₁ が 0.1 ~ 0.5 mmの範囲 となる。また、前記半導体レーザ1 e と前記光検出器 1 c との距離は 0.193~0.772 mmの範囲とな る。従って、本発明においては、半導体レーザ1eと半 導体レーザ1aとの距離を0.1~0.5 mmの範囲に設 定して設置し、波長480nmのレーザビームと波長7 80 nmのレーザビームの光ディスクの信号記録面から の反射光を前記光検出器1 c の同一位置で検出する。こ の場合、半導体レーザ1eを中心にして半導体レーザ1 aが光ディスクの外周方向に位置するように、光検出器 1 c が光ディスクの内周方向に位置するように配置され ている。

【0047】また、半導体レーザ1 aと半導体レーザ1 eとは0.1~0.5 mmの範囲で設置位置が異なるが、この範囲のずれは光ディスクに照射されるレーザビームの光軸のずれによる再生特性の劣化として現れることはない。また、更に、前記半導体レーザ1 aと前記半導体レーザ1 eとの設置位置の方向は光ディスクの径方向に限らず、周方向であってもよい。

【0048】また、更に、前記半導体レーザ1a、1e と前記光検出器1cのマウントについては上記第1の実施の形態中の図5に示すマウントと同じである。また、更に、前記開口数変更手段293の具体例としては、上記第1の実施の形態中の図6、7、8に示す具体例が本第3の実施の形態の前記開口数変更手段293にも使用できる。

【0049】基板厚1.2mmのCD、CD-Rと基板 厚0.3mmの高密度DVDとの再生動作は上記第1の 実施の形態中の図9、10で説明した動作と同様であ る。また、本第3の実施の形態における光ピックアップ 装置は、前記光ピックアップ291の構成に限らず、図 31に示すものであってもよい。即ち、図29に示す構 成では半導体レーザ1 a、1 e、光検出器1 c 及びホロ グラム1hは1つの光学手段292中に配置されていた が、これに限らず、図31に示すようにホログラム29 7が光学手段292と分離した構成の光ピックアップ3 11であってもよい。この場合、光学手段292中の半 導体レーザ1a、1eとホログラム297との距離、半 導体レーザ1aと半導体レーザ1eとの距離、半導体レ ーザ1eと光検出器1cとの距離、ホログラム297の ピッチは図30に示したものと同じである。また、光学 手段292とホログラム297以外の構成要素は図29 と同じであるので、その機能の説明についても省略す

【0050】また、本第3の実施の形態における光ピッ 50 クアップは、更に、図32に示す構成のものであっても

よい。図32に示す光ピックアップ321は図29に示 す光ピックアップ291の前記光学手段292と前記開 口数変更手段293との間にコリメータレンズ298を 挿入した構成である。光学手段292中の半導体レーザ 1 a、1 eとホログラム1 hとの距離、半導体レーザ1 aと半導体レーザ1eとの距離、半導体レーザ1eと光 検出器1cとの距離、ホログラム1hのピッチは図30 に示したものと同じである。それ以外は光ピックアップ 291と同じであるので、その他の説明については省略

【0051】また、本発明における光ピックアップは、 更に、図33から36に示す構成のものであってもよ い。図33から36に示す光ピックアップは、図29の 光ピックアップ291においてホログラム297が光学 手段292と分離し、コリメータレンズ298が追加に なった構成である。この場合においても光学手段292 中の半導体レーザ1a、1eとホログラム297との距 離、半導体レーザ1 aと半導体レーザ1 e との距離、半 導体レーザ1eと光検出器1cとの距離、ホログラム2 97のピッチは図30に示したものと同じである。ま た、ホログラム297は、図33に示すようにコリメタ レンズ298の手前にあってもよく、図34に示すよう にコリメータレンズ298の直後にあってもよい。ま た、更に、ホログラム297はコリメータレンズ298 と一体になっていてもよく、この場合も図35、36に 示すようにコリメータレンズ298の手前側、後側の表 面にホログラム297が設けられていてもよい。

【0052】基板厚が1.2mmのCD、CD-Rと基 板厚が 0.3 mmの高密度 DVDとを互換再生する再生 装置は、上記第1の実施の形態中の図17に示した装置 30 と同じ再生装置を使用できる。上記第1から第3の実施 の形態においては光ディスクからの再生について説明し たが、これに限るものではなく、上記説明した各光ピッ クアップ装置を用いて光ディスクへの記録を行うことが できる。

【0053】また、更に、上記第1から第3の実施の形 態においては、光学手段から生成されるレーザビームの 波長は635nmと780nm、480nmと635n m、および480nmと780nmとの組み合わせにつ いて説明したが、これに限るものではなく、他の波長の 40 レーザビームの組み合わせであってもよいことは言うま でもない。

[0054]

【発明の効果】本発明によれば、光源に波長が635n mと波長が780nmの異なる2つの半導体レーザを使 用するので、基板厚 0.6 mmの光ディスクであるD V Dと基板厚が1.2mmの光ディスクであるCD-Rと の互換再生をすることができる。

【0055】また、本発明によれば、光源に波長が48 0 nmと波長が635 nmの異なる2つの半導体レーザ 50 の光ディスクの再生動作を説明する図である。

を使用するので、基板厚 0.3 mmの光ディスクである 高密度DVDと基板厚が 0.6 mmの光ディスクである DVDとの互換再生をすることができる。また、本発明 によれば、光源に波長が480nmと波長が780nm の異なる2つの半導体レーザを使用するので、基板厚 0.3mmの光ディスクである高密度DVDと基板厚が 1.2 mmの光ディスクであるCD、CD-Rとの互換

【0056】また、本発明によれば、レーザビーム生成 10 手段、光検出手段、ホログラムを一体化した光学手段を 用いるので、光ピックアップを構成するのにハーフミラ ー、立ち上げミラーを用いる必要が無く、コンパクトな 光ピックアップを作製できるとともに低コストにも繋が る。また、本発明によれば、従来の光学系とほぼ同様の 構成で、CD-Rも再生可能な光ピックアップを実現で きる。

【0057】また、本発明によれば、波長635nmの レーザビームに対して光軸調整をすれば波長780nm のレーザピームに対しても光軸調整ができる。また、本 発明によれば、波長480nmのレーザビームに対して 光軸調整をすれば波長635nmのレーザビームに対し ても光軸調整ができる。また、本発明によれば、波長4 80 nmのレーザビームに対して光軸調整をすれば波長 780nmのレーザピームに対しても光軸調整ができ

【図面の簡単な説明】

再生をすることができる。

【図1】第1の実施の形態における光ピックアップの構 成を示す図である。

【図2】第1の実施の形態から第3の実施の形態におけ る半導体レーザ、ホログラム、光検出器相互間の距離の 計算方法を説明する図である。

【図3】第1の実施の形態から第3の実施の形態におけ る2つの半導体レーザ、ホログラム、光検出器相互間の 距離の計算方法を説明する図である。

【図4】第1の実施の形態における2つの半導体レー ず、ホログラム、光検出器相互間の距離の計算結果を示 す図表である。

【図5】第1の実施の形態から第3の実施の形態におけ る半導体レーザ、光検出器のマウントを説明する図であ

【図6】第1の実施の形態から第3の実施の形態におけ る開口数変更手段の具体例を示す図である。

【図7】第1の実施の形態から第3の実施の形態におけ る開口数変更手段の他の具体例を示す図である。

【図8】第1の実施の形態から第3の実施の形態におけ る開口数変更手段の他の具体例を示す図である。

【図9】第1の実施の形態における基板厚0.6mmの 光ディスクの再生動作を説明する図である。

【図10】第1の実施の形態における基板厚1.2mm

【図11】第1の実施の形態における光ピックアップの 他の構成を示す図である。

【図12】第1の実施の形態における光ピックアップの 更に、他の構成を示す図である。

【図13】第1の実施の形態における光ピックアップの 更に、他の構成を示す図である。

【図14】第1の実施の形態における光ピックアップの 更に、他の構成を示す図である。

【図15】第1の実施の形態における光ピックアップの 更に、他の構成を示す図である。

【図16】第1の実施の形態における光ピックアップの 更に、他の構成を示す図である。

【図17】第1の実施の形態から第3の実施の形態における再生装置を説明する図である。

【図18】CD、CD-R、およびDVDの定格値と再生条件を示す図表である。

【図19】DVDと高密度DVDの定格値と再生条件を示す図表である。

【図20】第2の実施の形態における光ピックアップの 構成を示す図である。

【図21】第2の実施の形態における2つの半導体レーザ、ホログラム、光検出器相互間の距離の計算結果を示す図表である。

【図22】第2の実施の形態における光ピックアップの 他の構成を示す図である。

【図23】第2の実施の形態における光ピックアップの 更に、他の構成を示す図である。

【図24】第2の実施の形態における光ピックアップの 更に、他の構成を示す図である。

【図25】第2の実施の形態における光ピックアップの 30 更に、他の構成を示す図である。

【図26】第2の実施の形態における光ピックアップの 更に、他の構成を示す図である。

【図27】第2の実施の形態における光ピックアップの 更に、他の構成を示す図である。

【図28】CD、CD-R、および高密度DVDの定格値と再生条件を示す図表である。

【図29】第3の実施の形態における光ピックアップの

構成を示す図である。

【図30】第3の実施の形態における2つの半導体レーザ、ホログラム、光検出器相互間の距離の計算結果を示す図表である。

【図31】第3の実施の形態における光ピックアップの 他の構成を示す図である。

【図32】第3の実施の形態における光ピックアップの 更に、他の構成を示す図である。

【図33】第3の実施の形態における光ピックアップの 10 更に、他の構成を示す図である。

【図34】第3の実施の形態における光ピックアップの 更に、他の構成を示す図である。

【図35】第3の実施の形態における光ピックアップの 更に、他の構成を示す図である。

【図36】第3の実施の形態における光ピックアップの 更に、他の構成を示す図である。

【符号の説明】

1・・・光学手段

1 a、1 b、1 e・・・半導体レーザ

20 1 c・・・光検出器

1d、1g、1h、2、207、297・・・ホログラム

3、208、298・・・コリメータレンズ

4・・・開口数変更手段

5・・・対物レンズ

6・・・アクチュエータ

7、77・・・基板

7a、77a・・・信号記録面

10・・・光ピックアップ

30 11・・・ブリアンブ

12・・・サーボ回路

13・・・サーボ機構

14・・・判別回路

15・・・指令回路

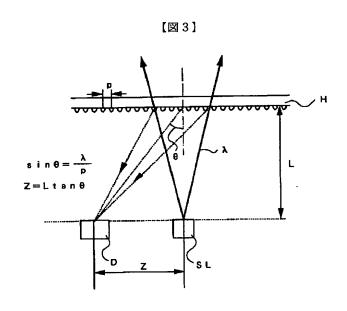
16・・・RF復調回路

17・・・特性切替回路

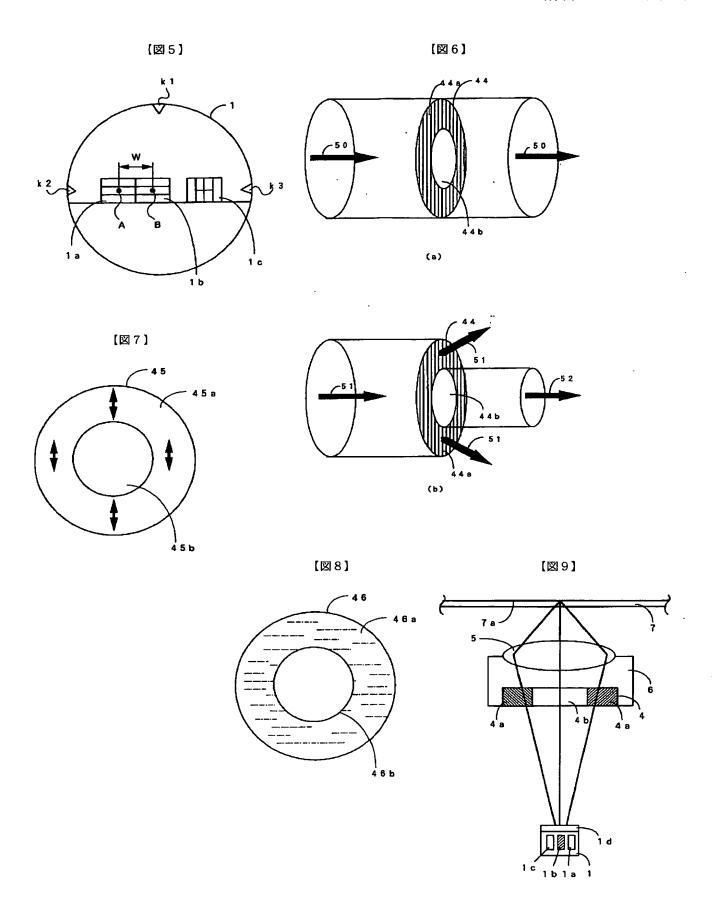
18・・・レーザ駆動回路

19・・・制御回路

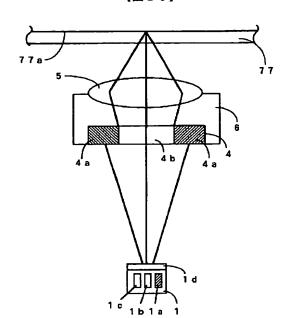
[図4]



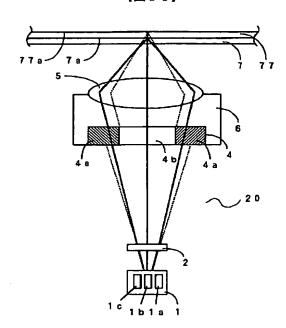
本ログラムの ピッチ:p (µm)	現代点と本ログラム間 の拒集:L(mm)		780nmのビームの発生点と 独出点との原物 : 2 ₂ (mm)	Z z – Z 1 (mm)
1.5	3	1.4018	1.8283	0.4245
2	8	1.0044	1.2708	0.2662
8	5	1.0828	1.3483	0.2685
3	4.5	0.9745	1.2116	0.2371
3	4	0.6663	1.0770	0.2107
5	5	0.8402	0.7887	0.1490
4.5	1 5	2.1381	2.6399	0.5019
Б	15	1.9205	2.3680	D.4464
8	15	1.1944	1.4695	0.2750
10	10	0.6360	0.7823	0.1464
1 0	15	0.9544	1.1735	0.2192
10	8 .	0.5090	0.8259	0.1169
В	10	0.7963	0.9797	0.1834
5	10	1.2804	1.5793	0.2989
3	10	2.1657	2.6926	0.5268
В	2 5	1.9906	2.4492	0.4506
10	2 5	1.5907	1.9560	0.3653
1 5	2 5	1.0593	1.3018	0.2425
2 0	2 5	0.7942	0.9787	0.1815
2 5	2 5	0.6352	0.7804	0.1452
3 0	2 5	0.5293	0.6502	0.1209
3.5	2 5	0.4536	0.5572	0.1037



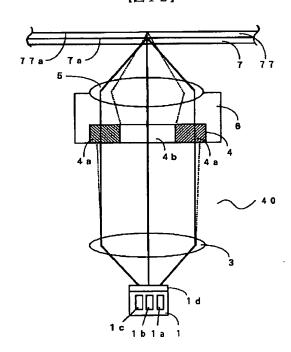
[図10]



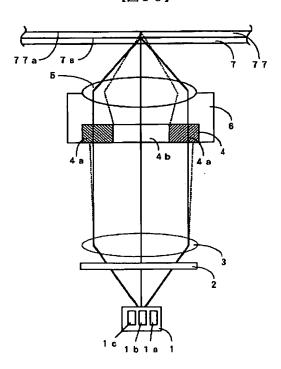
[図11]

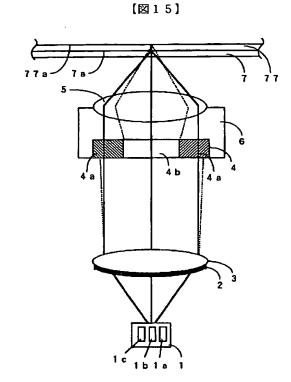


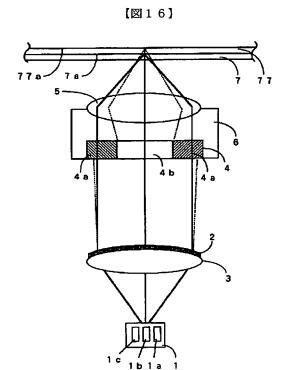
【図12】



[図13]



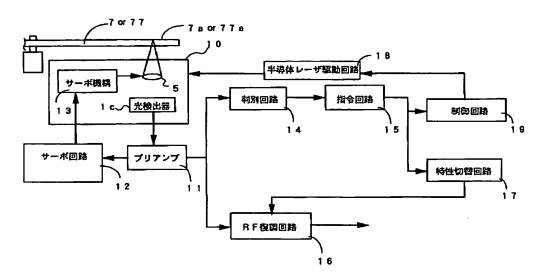




DVD高密度DVD 跳取面側 基 板 厚 0.6 mm (0.5 5~0.8 5 mm) 0.3 mm (0.2 5 ~ 0.3 5 mm) 0.4 0 μm (0.3~0.5 μm) 0.3 0 µm (0.2~0.4 µm) 定 最短ピット長 格 0.7 4 μm (0.7 3~0.7 5 μm) 籄 トラックピッチ 40%以上 15~40% 40%以上 15~40% 反射率 $0.7 \mu \text{m}$ ($0.85 \sim 0.75 \mu \text{m}$) 再 0.9 μm (0.8 5 ~ 0.9 5 μm) スポット径 生 0.65 (0.60~0.70) 0.60 関ロ数 夈 635 (620~660) 4 8 0 (3 5 0 ~ 5 5 0) 波長

【図19】

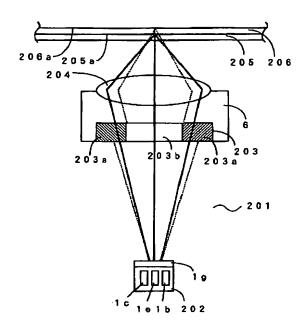
【図17】



【図18】

種 類		CD	CD-R	DVD	
定格位	施取面例 基 板 厚	1.2 mm (1.1~1:3 mm)	1.2 mm (1.1~1.3 mm)	0.6 mm (0.5 5~0.6 5 mm)	
	最短ピット長	0.83μm (0.80~0.9μm)	0.83μm (0.80~0.9μm)	0.4 0 μm · (0.3~0.5 μm)	
	トラックピッチ	1.θμm (1.5~1.7μm)	1.6μm (1.5~1.7μm)	0.7 4 μm (0.7 3 ~ 0.7 5 μm)	
	反射率	80~70%以上 :	60~70%GLE	40%QL 15~40%	
再生条件	スポット径	1.5 μm (1.4 ~ 1.8 μm)	1.5μm (1.4~1.6μm)	0.9 μm (0.8 5 ~ 0.8 5 μm)	
	舞口数	0.45 (0.40~0.50)	0.45 (0.40~0.50)	0.60 (0.55~0.65)	
	波長	780 (750~800)	780 (760~800)	635 (620~560)	

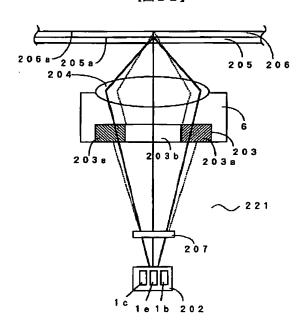
[図20]



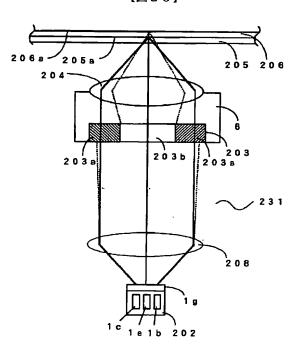
[図21]

ホログラムの ピッチェク (un)	発光点と本ログラム間 の圧撃:L(mm)		6 3 5 nmのビームの数定点と 数式点との変形 : 2 g (mm)	2 z – 2 1 (mm)
1 2	1 0	0.4003	0.5299	0.130
1 2	1 6	0.6005	0.7949	0.1944
1 2	В	0.3203	0.4239	0.104
10	1 5	0.7208	0.9544	0.2340
10	10.	0.4805	0.6363	0.1558
10	8	0.3844	0.5090	0.1246
10	7	D.3364	0.4454	0.1090
8	1 5	0.9016	1.1944	0.2930
8	1 0	0.6011	0.7983	0.1952
8	8	0.4808	0.6370	0.1562
Ð	6 .	0.3606	0.4778	0.1172
5	15	1.4467	"1.9 Z D B	0.4740
5	10	0.9645	1.2804	0.3159
5	6	0.4822	0.6402	0.1580
5	3	0.2893	0.3841	0.0948
3	8	1.2967	1.7926	0.4359
3	5	0.8104	1.0 B 2 9	0.2724
3	3	0.4863	0.6497	0.1834

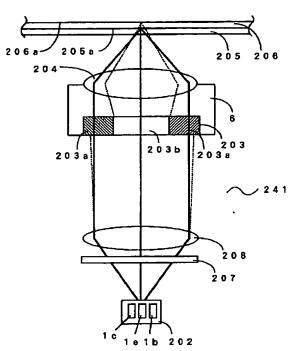
【図22】



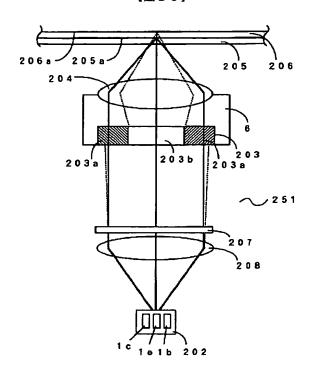
[図23]



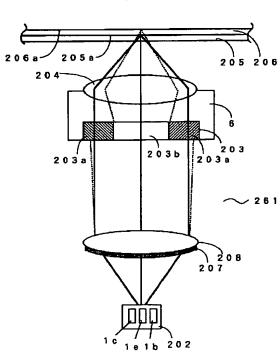
【図24】



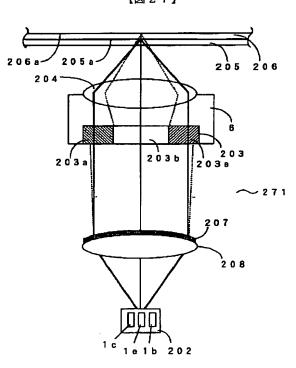
【図25】



[図26]



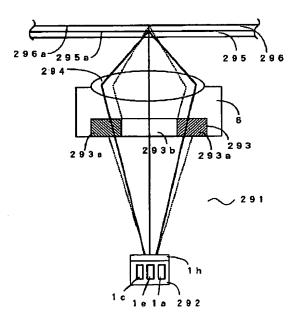
【図27】



【図28】

	(1) AI	CD	CD-R	高密度	DVD
	使取面倒 基 板 厚	1.2mm (1.1~1.3mm)	1.2 mm (1.1 ~ 1.3 mm)	0.3 mm (0.2 5 ~ 0.3 5 mm)	
定	最短ピット長	0.83μm (0.80~0.9μm)	0.83 μm (0.80~0.9 μm)	0.30µm (0.20~0.40µm)	
格值	トラックピッチ	1.6μm (1.5~1.7μm)	1.6μm (1.5~1.7μm)		6μm 0.57μm)
	反射率	70%以上	60~70%	40%ELE	15~40%
Ħ	スポット径	1.5 μm (1.4~1.6 μm)	1.5 µm (1.4~1.6 µm)	0.70μm (0.65~0.75μm)	
再生条件	関口数	0.45 (0.40~0.50)	0.45 (0.40~0.50)	0.60 (0.55~0.65)	
	波長	780nm (760~800nm)	780nm (780~800nm)		0 nm 5 5 0 nm)

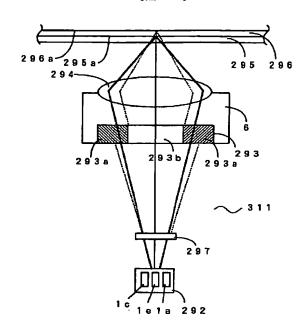
[図29]



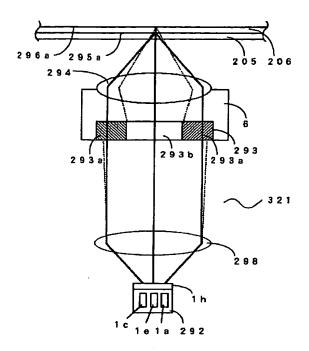
【図30】

本ログラムの ピッチ:p(u m)	発光点と本ログラ人間 40個種:L(mm)	4 8 0 a mのピームの発光点と 後点点との距離: Z ₁ (mm)	7 8 D n m のピームの最先点と 独出点との影響 : Z g (m m)	Z 2 – Z 1 (mm)
1 2	10	0.4003	0.6514	0.251
1 2	1 5	0.8005	0.8771	0.3786
1 2	5	0.2002	0.9257	0.1255
1 0	15	0.7208	1.1746	0.4528
1 0	10	0.4805	0.7824	0.3019
1.0	8	0.3844	0.6259	0.2415
10	5	0.2403	0.8912	0.150B
8	10	0.8011	0.9797	0.3788
В	5	0.8005	0.489B	D.1883
5	В	0.7718	1.2835	0.4919
8	5 ·	0.4822	0.7897	0.3075
5	9	0.2893	0.4738	0.1845
5	2	0.1929	0.3159	0.1230

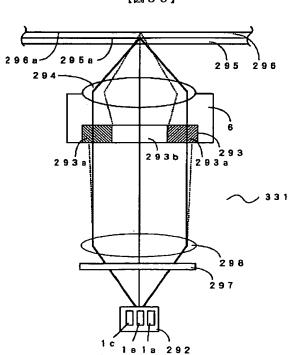
【図31】



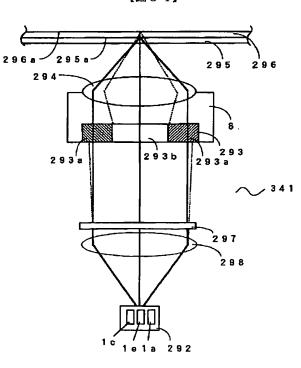
【図32】



【図33】



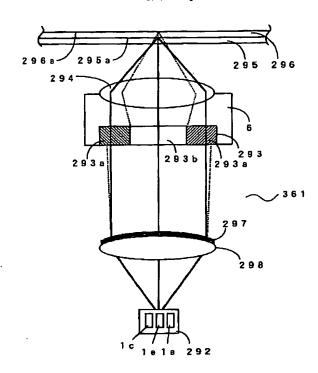
【図34】



[図35]

296a 295a 295 296 293b 293a 293a 351

【図36】



フロントページの続き

(72)発明者 土屋 洋一 大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三 洋電機株式会社内

(72)発明者 市浦 秀一 大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三 洋電機株式会社内

1